

теролазеров. Вирро А. Л., Лыук П. А., Раммо И. Х.-Ф., Фриден-тал Я. К., Халлер Ю. Э. 7, 1158  
Низкопороговые квантово-размерные AlGaAs-гетеролазеры для диапазона длин волн 730—850 нм, полученные методом низкотемпературной ЖФЭ. Андреев В. М., Аксенов В. Ю., Казанцев А. Б., Пруцких Т. А., Румянцев В. Д., Танклевская Е. М., Хвостиков В. П. 10, 1757  
Электронно-зондовые исследования деградации непрерывных инжекционных гетеролазеров. Кошкин С. Г., Свердлов М. И., Филиппенко В. Я., Хазанов А. А. 11, 2010

## 19. Экспериментальные методы

Полевая релаксационная спектроскопия локализованных электронных состояний в системах полупроводник—диэлектрик. Гольдман Е. И., Ждан А. Г., Кольчов А. М., Маркин Ю. В. 1, 159  
Определение электрофизических параметров полупроводников методом математического моделирования сигнала индуцированного тока. Кошкин С. Г., Поссе В. А., Соловьев В. А., Уманский В. Е., Чистяков В. М. 2, 271  
Проявление дискретных уровней при релаксационной спектроскопии локализованных электронных состояний с непрерывным спектром. Гольдман Е. И., Ждан А. Г., Сумарока А. М. 3, 503  
Новый способ обработки спектров DLTS. Астрова Е. В., Лебедев А. А. 3, 549

Измерение ВАХ InGaAs при помощи пикосекундной электрооптической стробоскопической установки. Балинас В., Гореленок А. Т., Кроткус А., Стадненис А., Шмидт Н. М. 5, 848  
О применимости метода температурной зависимости емкости и активной проводимости для определения параметров глубоких центров в перекомпенсированном полупроводнике. Берман Л. С., Ломасов В. Н., Каченко В. Н. 10, 1841  
Метод определения отношений сечений фотоионизаций для многозарядных акцепторов в полупроводниках. Корнилов Б. В. 10, 1867  
О влиянии рекомбинации носителей заряда на параметр сигнала в методе фотодефекционной спектроскопии. Григорьев В. В., Зуев В. В., Мехтиев М. М., Петровский А. Н., Сальник А. О. 11, 2031  
Оценка точности метода определения раздельной концентрации примесей из измерений постоянной Холла. Банная В. Ф., Веселова Л. И., Гершензон Е. М., Гусинский Э. Н., Литвак-Горская Л. Б. 12, 2145  
Об определении энергии ионизации глубоких уровней из данных DLTS. Вывенко О. Ф., Базлов Н. В., Целищев С. Л. 12, 2208

## 20. Юбилей и даты

Шмарцев Юрий Васильевич (к 60-летию со дня рождения). 2, 393  
Памяти Анатолия Робертовича Регеля. 5, 954  
Памяти Олега Вячеславовича Снитко. 6, 1148

## 21. Исправления к статьям

Исправление к статье «ГХ-перенос в реальном пространстве: N-ОДП в слоистой структуре». Грибников З. С., Райчев О. Э. 5, 940  
Исправление к статье «Спектральная память фотопроводимости высокоомного ZnSe» (ФТП. 1989. Т. 23. В. 11. С. 2090—2093). Горя О. С., Ковалев Л. Е., Коротков В. А., Маликова Л. В., Симашкевич А. В. 8, 1496

## 22. О новых книгах

Новые книги по полупроводникам. Козуб В. И. 5, 943; 8, 1499; 10, 1893; 12, 2225